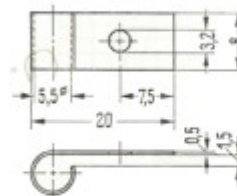
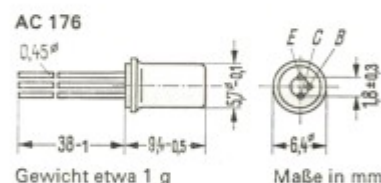
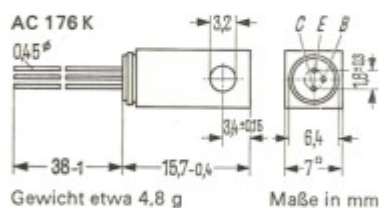


**AC 176, AC 176 K kompl. gepaart AC 176/AC 153 NPN/PNP****NPN-Transistor für NF-Endstufen bis 3,5 W**

AC 176 ist ein legierter NPN-Germanium-Transistor im Gehäuse 1 A 3 DIN 41871 (TO-1 ähnlich). Die Anschlüsse sind vom Gehäuse elektrisch isoliert. Der Kollektoranschluß wird mit einem roten Punkt am Gehäuserand gekennzeichnet.

Zur Befestigung auf einem Chassis ist ein Befestigungsteil (Kühlschelle<sup>1)</sup>) vorgesehen, dieses ist zusätzlich zu bestellen. Der Transistor AC 176 K hat ein Vierkantgehäuse und kann direkt mit gutem Wärmekontakt auf das Chassis montiert werden. Der Kollektoranschluß des AC 176 K ist durch eine kleine Vertiefung im Kühlblock gekennzeichnet. AC 176 und AC 176 K, zur Verwendung in NF-Endstufen bis 3,5 W, sind zusammen mit AC 153/153 K auch als komplementäre Paare lieferbar.

Typ	Bestellnummer
AC 176	Q60103-X176
AC 176 kompl. gep.	Q60103-X176-S5
AC 176 K	Q60103-X176-K
AC 176 K kompl. gep.	Q60103-X176-S3
Kühlschelle	Q62901-B1

Befestigungsteil (Kühlschelle)<sup>1)</sup>**Grenzdaten**

Kollektor-Emitter-Spannung  
 Kollektor-Basis-Spannung  
 Emitter-Basis-Spannung  
 Kollektorstrom  
 Basisstrom  
 Sperrschichttemperatur  
 Lagertemperatur  
 Gesamtverlustleistung  
 Wärmewiderstand  
 Kollektorsperrschicht – Luft (AC 176)  
 Kollektorsperrschicht – Transistorgehäuse (AC 176)  
 Kollektorsperrschicht – Kühlblech unter der Befestigungsschraube; bei sorgfältiger Montage (AC 176 K)

$U_{CE0}$	18	V
$U_{CB0}$	32	V
$U_{EB0}$	10	V
$I_C$	1	A
$I_B$	0,1	A
$T_J$	90	°C
$T_S$	-55 bis +75	°C
$P_{tot}$	1,0	W
$R_{thJU}$	≤ 300	grd/W
$R_{thJG}$	≤ 40	grd/W
$R_{thL}$	≤ 45	grd/W

<sup>1)</sup> Bei sorgfältiger Montage Wärmewiderstand zwischen Transistorgehäuse und Kühlblech unter der Befestigungsschraube  $R_{th} \leq 10 \text{ grd/W}$



**AC176, AC176 K** kompl. gepaart AC 176/AC 153 NPN/PNPStatische Kenndaten ( $T_U = 25^\circ\text{C}$ )

Für folgende Arbeitspunkte gilt:

$U_{CB}$ V	$I_C$ mA	$I_B$ mA	$\frac{B}{I_C/I_B}$	$U_{BE}$ V
0	50	1,4	35	< 0,3
0	300	2,7 (1,2 bis 6)	110 (50 bis 250)	< 0,65
0	1000	33,3	30	< 1

Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung ( $I_C = 1\text{ A}$ )

für die Kennlinie, die bei konstantem Basisstrom durch

den Kennlinienpunkt  $I_C = 1,1\text{ A}$ ;  $U_{CE} = 1\text{ V}$  geht)  $U_{CE\text{sat}} | < 0,6$  | V

	$T_U$	90	25	$^\circ\text{C}$
Kollektor-Emitter-Reststrom ( $U_{CEV} = 32\text{ V}$ ; $-U_{BE} = 0,6\text{ V}$ )	$I_{CEV}$	1 (< 3)	—	mA
Kollektor-Basis-Reststrom ( $U_{CBO} = 10\text{ V}$ )	$I_{CBO}$	—	7 (< 35)	$\mu\text{A}$
Kollektor-Basis-Reststrom ( $U_{CBO} = 32\text{ V}$ )	$I_{CBO}$	1000 (< 3000)	25 (< 500)	$\mu\text{A}$
Emitter-Basis-Reststrom ( $U_{EBO} = 10\text{ V}$ )	$I_{EBO}$	—	20 (< 200)	$\mu\text{A}$

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

( $I_{CEO} = 300\text{ mA}$ ) $U_{(BR)CEO} | > 18$  | V

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung

( $I_{CBO} = 500\text{ }\mu\text{A}$ ) $U_{(BR)CBO} | > 32$  | V

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

( $I_{CBO} = 200\text{ }\mu\text{A}$ ) $U_{(BR)EBO} | > 10$  | VDynamische Kenndaten ( $T_U = 25^\circ\text{C}$ )Transitfrequenz ( $I_C = 10\text{ mA}$ ;  $U_{CE} = 2\text{ V}$ ) $f_T | 3 (> 1)$  | MHz

Kollektor-Basis-Kapazität

( $U_{CBO} = 5\text{ V}$ ;  $f = 450\text{ kHz}$ ) $C_{CBO} | 100$  | pF